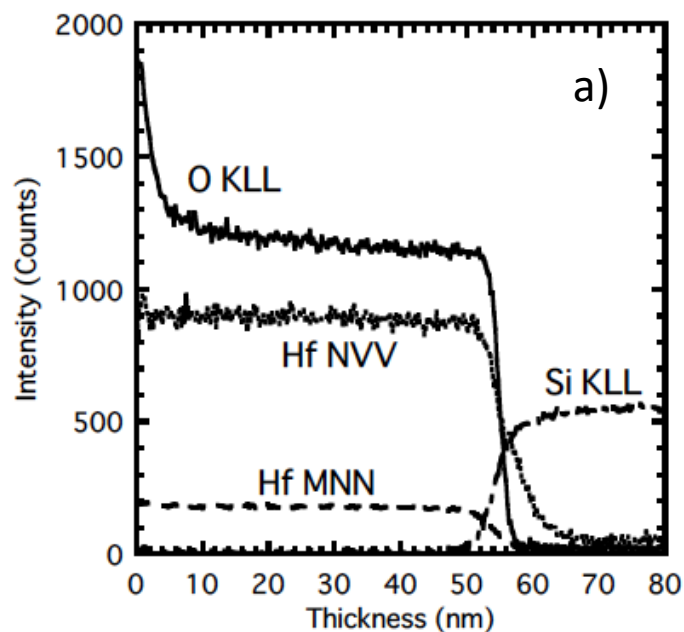


研究論文, ” 極低角度入射ビームオージェ深さ方向分析によるHfO₂/Si基板の分析” に掲載されている Fig. 9
オージェデプスプロファイルの Raw data ファイル

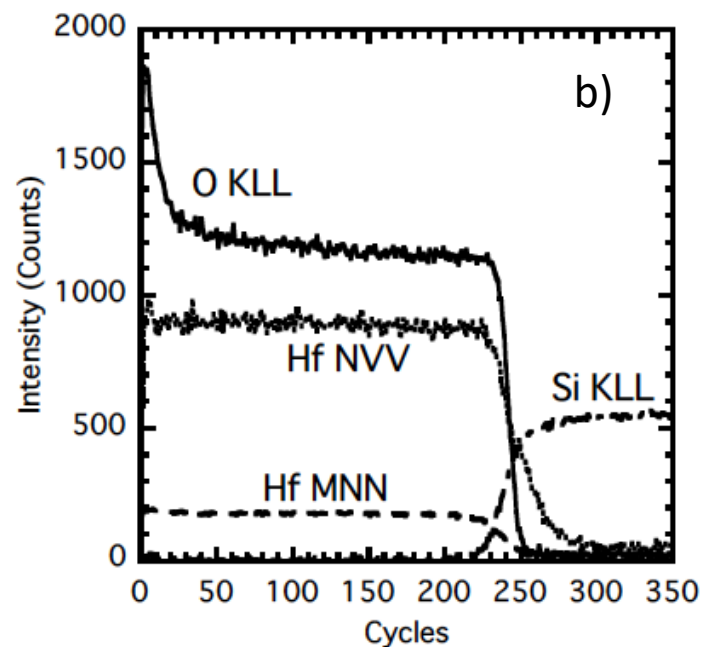
DOI

<https://doi.org/10.1384/jsa.24.192>

荻原俊弥, 長田貴弘, 吉川英樹, *J. Surf. Anal.* **24**, 192 (2018).



AES depth profiles of the HfO₂:55 nm/Si substrate using the conventional method with the argon ion energy of 0.5 keV.



AES depth profiles of the HfO₂:55 nm/Si substrate using the conventional method with the argon ion energy of 0.5 keV.

a) のオージェデプスプロファイルは論文に掲載の Fig. 9 に相当し, 横軸は nm である.
b) は横軸を測定回数で表したものであり, 横軸を nm に変換する前のプロファイルである.
Raw data ファイルは, b) に対応している.